



摘要

本指南介绍确保 TRF1208-EVM 正确运行和快速设置所需的基本步骤和功能。本文还概述了原理图、物料清单 (BOM)、印刷电路板 (PCB) 布局和测试方框图。除非特别说明，否则本文档中的缩写词 *EVM*、*TRF1208 EVM* 以及术语 *评估模块* 均代表 TRF1208-EVM。

内容

| | |
|---------------------------|----|
| 1 说明 | 2 |
| 1.1 特性..... | 2 |
| 1.2 一般使用信息..... | 3 |
| 2 EVM 概览 | 4 |
| 2.1 原理图..... | 4 |
| 2.2 PCB 板层..... | 5 |
| 2.3 TRF1208 EVM 物料清单..... | 6 |
| 2.4 堆叠和材料..... | 7 |
| 3 测试设置图 | 8 |
| 3.1 S 参数测试设置..... | 8 |
| 3.2 噪声系数测试设置..... | 9 |
| 3.3 双音 OIP3 测试设置..... | 9 |
| 4 相关文档 | 11 |
| 5 修订历史记录 | 11 |

插图清单

| | |
|---|---|
| 图 1-1. 增益和输出 P1dB 的单音设置..... | 2 |
| 图 2-1. TRF1208 EVM 原理图..... | 4 |
| 图 2-2. 顶层..... | 5 |
| 图 2-3. 第 2 层..... | 5 |
| 图 2-4. 第 3 层..... | 5 |
| 图 2-5. 底层..... | 5 |
| 图 2-6. TRF1208 EVM 堆叠 (以 mil 为单位) | 7 |
| 图 3-1. S 参数测试设置..... | 8 |
| 图 3-2. PCB 布线损耗与频率的关系..... | 8 |
| 图 3-3. 噪声系数测试设置..... | 9 |
| 图 3-4. OIP3 测试设置..... | 9 |

表格清单

| | |
|-----------------------------|---|
| 表 2-1. TRF1208 EVM BOM..... | 6 |
|-----------------------------|---|

商标

Isola® is a registered trademark of Isola USA Corporation.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 说明

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208 器件，该器件为单端输入转差分输出射频放大器，采用 $2 \times 2\text{mm}^2$ 12 引脚 WQFN 封装。该器件用于在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入 ADC。TRF1208 有两种增益型号，即增益为 16dB 的 TRF1208A 和增益为 10dB 的 TRF1208B。除非另有说明，否则本文档中的所有 TRF1208 指 TRF1208 或 TRF1208B。

电路板专门针对 50Ω 单端输入匹配进行设置。该放大器具有低输出阻抗。电路板的输入和输出端具有交流耦合电容器。此 EVM 可随时连接到 $+3.3\text{V}$ 电源、信号源和测试仪表进行测量。

1.1 特性

- $+3.3\text{V}$ 单电源供电。
- 专为单端 50Ω 输入匹配而设计。
- 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端。
- 借助跳线连接器，电路板可提供断电选项。

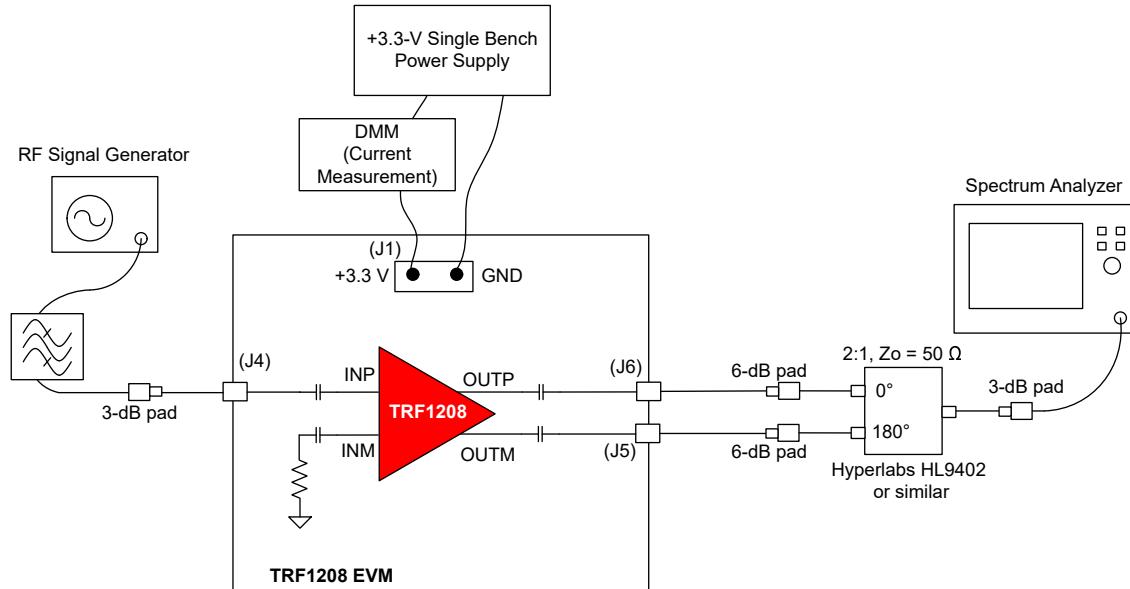


图 1-1. 增益和输出 P1dB 的单音设置

1.2 一般使用信息

本节提供 TRF1208 EVM 的一般使用信息。有关作为后续说明基准点的一般单音设置图，请参阅图 1-1（为清晰起见，省略了某些元件，如电源旁路电容器）：

1. 建议的加电序列：

- a. 在将电源电缆连接到 EVM 之前，将直流输出电源设置为 +3.3V。
- b. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
- c. 确保关闭电源，将电源电缆连接到 EVM 的 J1 连接器。
- d. 现在打开 VCC = +3.3V 的直流电源。从电源获取的电源电流 (I_Q) 约为 135mA。
- e. 如果电源电流较低，请验证器件是否通过 PD 引脚禁用。

2. 断电选项：

- a. 连接 PD 引脚上的 +1.8V（逻辑 1）可将芯片断电。将 PD 引脚接地可启用芯片。

3. 单音测量设置建议：

- a. 将射频信号发生器连接到输入 SMA 连接器 J4。

在测量单音失真时，请使用射频带通滤波器，如图 1-1 所示。

- b. 要测试 TRF1208 EVM，使用的射频信号发生器必须支持高达 12GHz 的信号频率。
- c. TRF1208 器件输入在通带内为 50Ω 。

为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射，TI 建议在电源和 J4 SMA 输入之间使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫。

- d. J5 和 J6 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分（或 180° 异相）输出。
TRF1208 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。

- e. 当连接到频谱分析仪时，必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号，如图 1-1 所示。

建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫，以尽可能减少反射。

- f. 最后，TI 建议正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗，以便准确测量器件的增益和功率等级。

4. 匹配注意事项：

- a. TRF1208 是一款宽带放大器，该器件在其高达 12GHz 的工作带宽上需要 50Ω 的输入匹配。用于驱动此 EVM 的信号发生器或噪声源在宽带宽上具有 50Ω 的阻抗。但如果此 EVM 由非 50Ω 匹配的窄带驱动器或源驱动，则放大器可能会出现不稳定问题。为了避免此类问题，可能需要在输入端进行额外的匹配。有关更多信息，请参阅 [TRF1208 单通道 10MHz 至 8GHz 1dB 带宽单端至差分放大器](#) 数据表。

- b. 如前文所述，TRF1208 器件具有低输出阻抗，并且 EVM 中使用了零欧姆串联电阻器。在将 EVM 输出连接到平衡-非平衡变压器时，TI 建议使用衰减器垫来尽可能减少反射。

2 EVM 概览

本节包含原理图、物料清单 (BOM)、PCB 印刷层和 EVM 堆叠信息。

2.1 原理图

图 2-1 显示了 TRF1208 EVM 原理图。

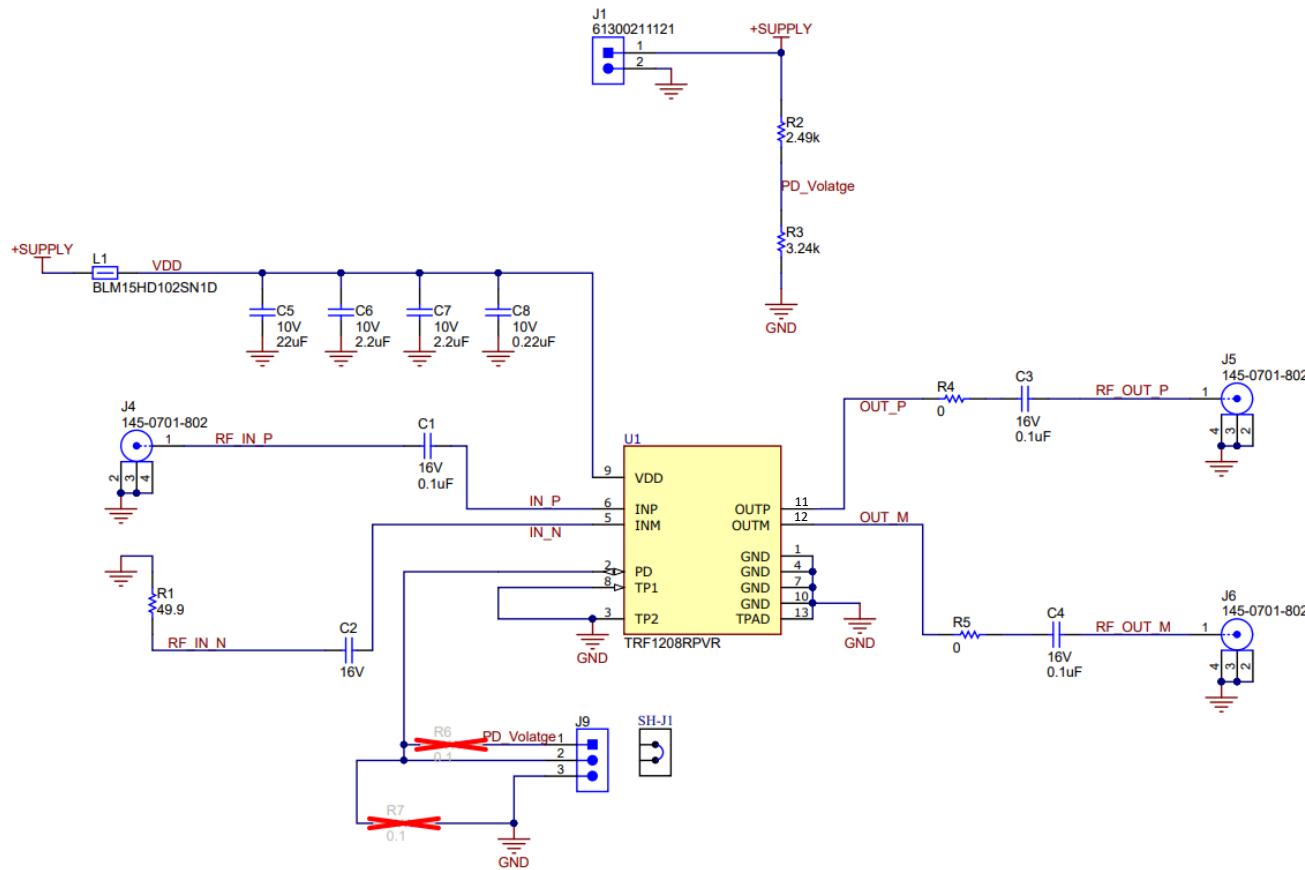


图 2-1. TRF1208 EVM 原理图

2.2 PCB 板层

图 2-2 至图 2-5 显示了此 EVM 的 PCB 板层。

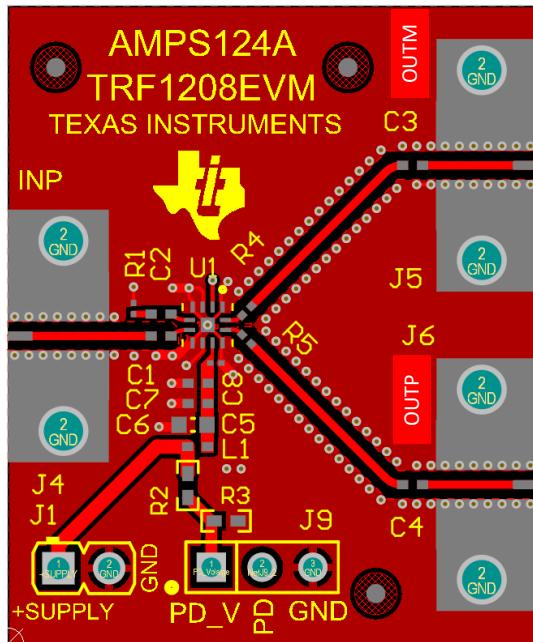


图 2-2. 顶层

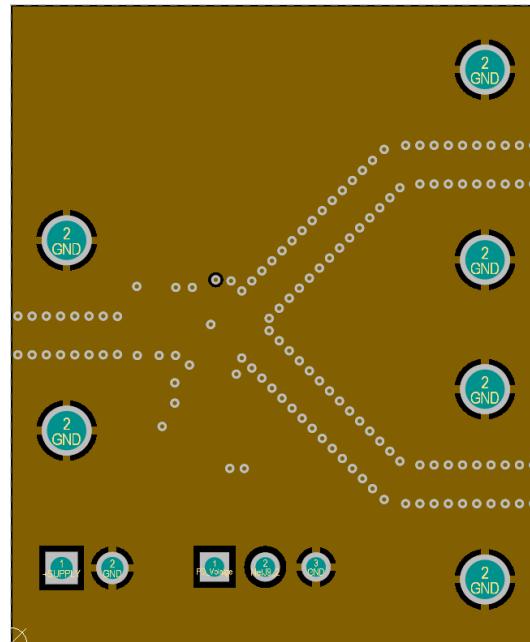


图 2-3. 第 2 层

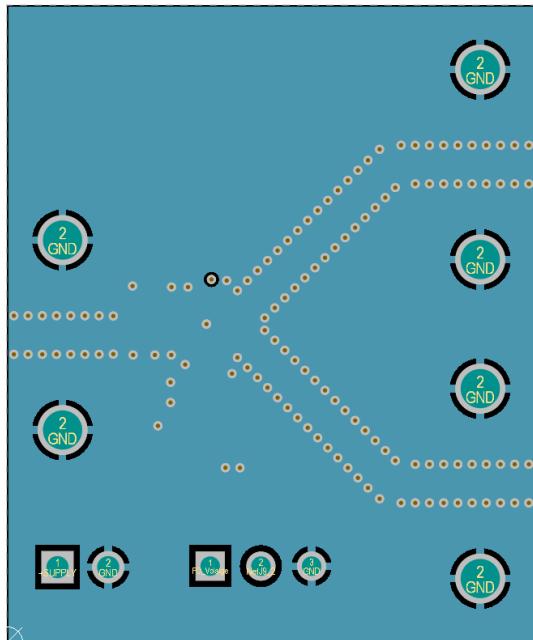


图 2-4. 第 3 层

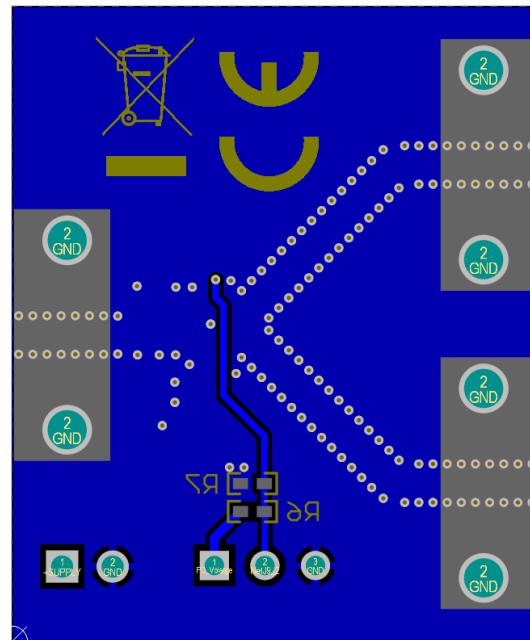


图 2-5. 底层

2.3 TRF1208 EVM 物料清单

表 2-1. TRF1208 EVM BOM

| 项目编号 | 代号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
|------|----------------|----|--------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---|----------------|-------|
| 1 | C1、C2、C3、C4 | 4 | 0.1μF | 电容，陶瓷，0.1μF，16V，±10%，X7R，0402 | 0402 | ATC530L104KT16T | AT Ceramics | | |
| 2 | C5 | 1 | 22μF | 电容，陶瓷，22μF，10V，±20%，X5R，0603 | 0603 | CL10A226MP8NUNE | Samsung Electro-Mechanics (三星电机) | | |
| 3 | C6、C7 | 2 | 2.2μF | 电容，陶瓷，2.2μF，10V，±10%，X7S，0402 | 0402 | C1005X7S1A225K050B C | TDK | | |
| 4 | C8 | 1 | 0.22μF | 电容，陶瓷，0.22μF，10V，±20%，X5R，0201 | 0201 | LMK063BJ224MP-F | Taiyo Yuden (太阳诱电) | | |
| 5 | J1 | 1 | | 接头，2.54mm，2x1，金，TH | 接头，2.54mm，2x1，TH | 61300211121 | Wurth Elektronik (伍尔特电子) | | |
| 6 | J4、J5、J6 | 3 | | 50Ω 插孔，SMT | 50Ω 插孔，SMT | 145-0701-802 | Cinch Connectivity | | |
| 7 | J9 | 1 | | 接头，100mil，3x1，锡，TH | 接头，3 引脚，100mil，锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions (赛凌思科技有限公司) | | |
| 8 | L1 | 1 | 1000 Ω | 铁氧体磁珠，1000Ω (在 100MHz 时)，0.25A，0402 | 0402 | BLM15HD102SN1D | MuRata (村田) | | |
| 9 | R1 | 1 | 49.9 | 电阻，49.9，1%，0.05W，AEC-Q200 1 级，0201 | 0201 | ERJ-1GEF49R9C | Panasonic (松下) | | |
| 10 | R2 | 1 | 2.49k | 电阻，2.49k，1%，0.063W，AEC-Q200 0 级，0402 | 0402 | CRCW04022K49FKED | Vishay-Dale (威世达勒) | | |
| 11 | R3 | 1 | 3.24k | 电阻，3.24k，1%，0.063W，AEC-Q200 0 级，0402 | 0402 | CRCW04023K24FKED | Vishay-Dale (威世达勒) | | |
| 12 | R4、R5 | 2 | 0 | 电阻，0，5%，0.05W，AEC-Q200 0 级，0201 | 0201 | ERJ-1GN0R00C | Panasonic (松下) | | |
| 13 | SH-J1 | 1 | 1x2 | 分流器，100mil，镀金，黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec (申泰) | 969102-0000-DA | 3M |
| 14 | U1 | 1 | | 射频 IC | WQFN-FCRLF12 | TRF1208RPVR | 德州仪器 (TI) | | |
| 15 | FID1、FID2、FID3 | 0 | | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 16 | R6、R7 | 0 | 0.1 | 电阻，0.1，1%，0.25W，0402 | 0402 | ERJ2BWFR100X | Panasonic (松下) | | |

2.4 堆叠和材料

TRF1208 EVM 是一款 67mil 4 层电路板，材料类型为 Isola® 370HR。顶层是电源布线、接地布线以及 SMA 连接器与器件之间的信号布线。第二层是参考射频接地层。信号布线阻抗目标为 50Ω 。底部 3 层是接地层。

| Layer | Stack up | Supplier | Supplier Description | Description | Base Thickness | Processed Thickness | ϵ_r |
|-------|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | | GOULD | COPPER FOIL | 12+35 m | 1.850 | 2.559 | |
| | ISOLA | 185HR | #2116 | 5.000 | 4.966 | 4.320 | |
| | ISOLA | 185HR | #2116 | 5.000 | 4.966 | 4.320 | |
| 2 | | | | | 1.378 | 1.378 | |
| 3 | | ISOLA | 185HR | 1.00 1.0/1.0 | 39.370 | 39.370 | 4.420 |
| | | | | | 1.378 | 1.378 | |
| 4 | | ISOLA | 185HR | #2116 | 5.000 | 4.966 | 4.320 |
| | ISOLA | 185HR | #2116 | 5.000 | 4.966 | 4.320 | |
| | GOULD | COPPER FOIL | 12+35 m | 1.850 | 2.559 | | |

图 2-6. TRF1208 EVM 堆叠 (以 mil 为单位)

3 测试设置图

本节包含测量 TRF1208 EVM 时有关 S 参数、噪声系数和双音 OIP3 设置的一般建议。

3.1 S 参数测试设置

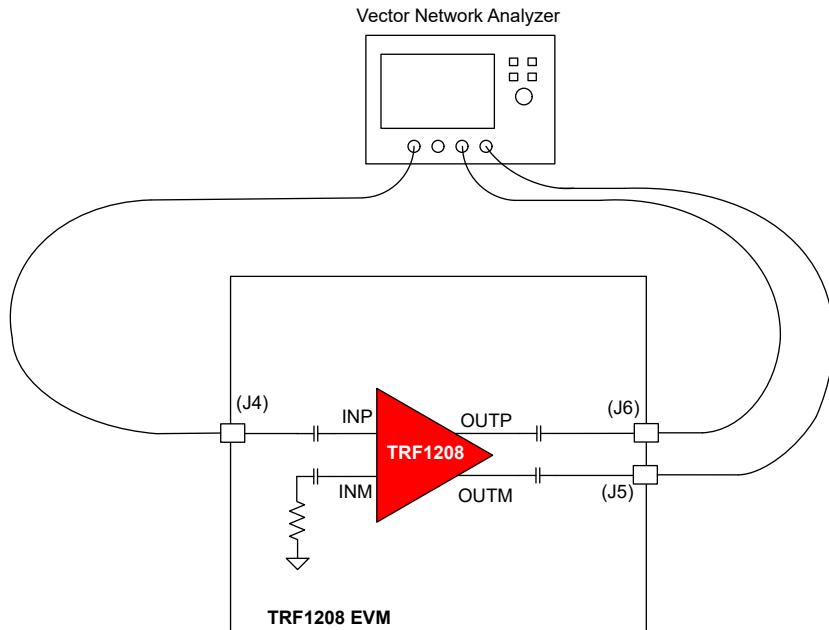


图 3-1. S 参数测试设置

请按照以下指南进行 S 参数测量：

1. 如图 3-1 所示，通常会使用矢量网络分析器 (VNA) 进行 S 参数测量。要测量 TRF1208 EVM，建议使用 3 端口 VNA，它可以分别在 EVM 的输入和输出端口产生单端信号和接收差分信号。
2. 在将射频同轴电缆连接到 EVM 之前，必须使用校准套件校准 VNA 以及电缆。
3. 确保将 VNA 的频率扫描和输出功率级别设置在 TRF1208 器件的线性工作范围内。可以调整 VNA 的分辨率带宽 (RBW) 和动态范围，以便为测量提供最佳扫描时间。
4. 在增益测量期间，在器件的输入和输出侧补偿电路板布线损耗。图 3-2 给出了在 EVM 上测量的典型输入和输出布线损耗。

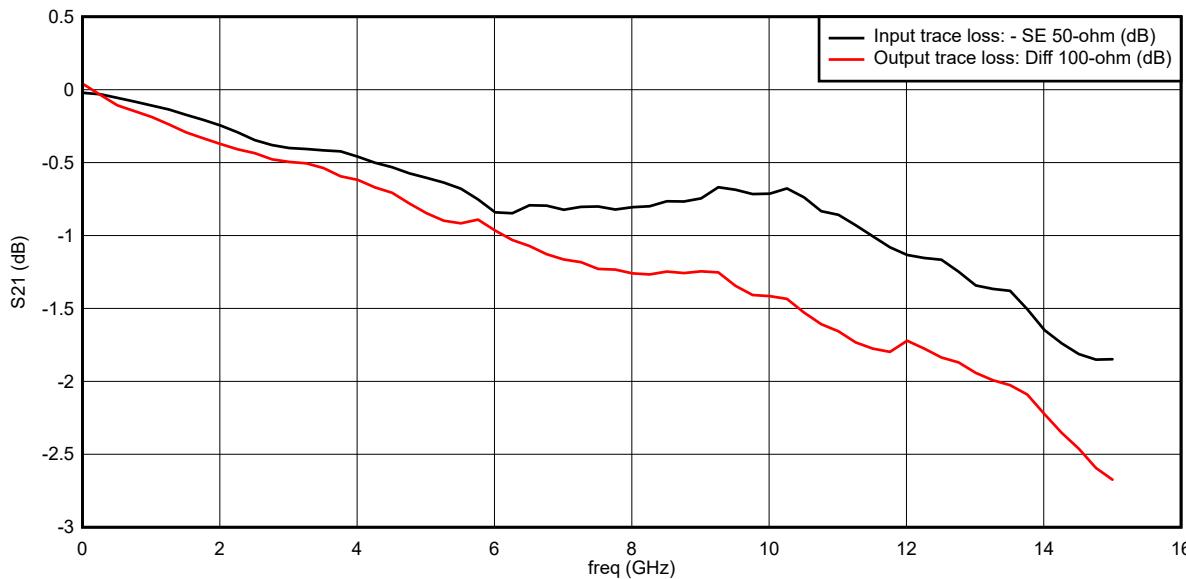


图 3-2. PCB 布线损耗与频率的关系

3.2 噪声系数测试设置

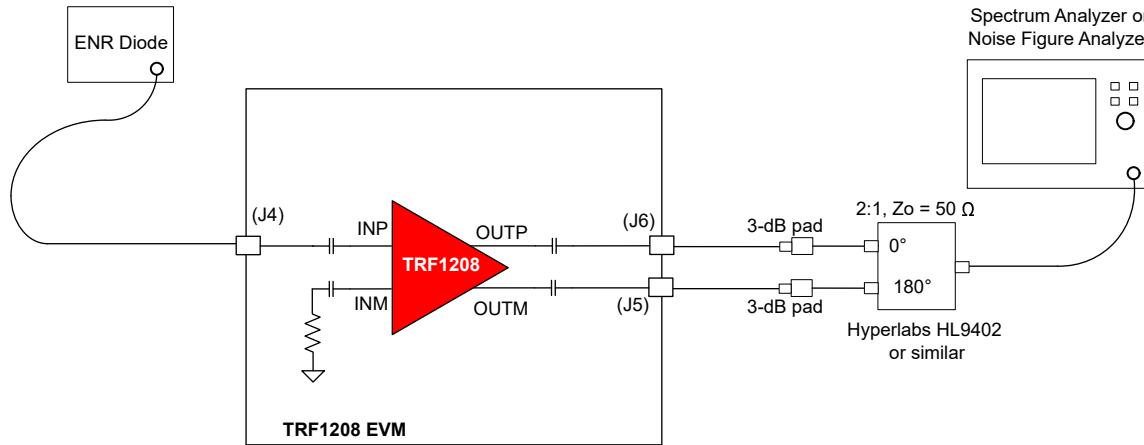


图 3-3. 噪声系数测试设置

请按照以下指南进行噪声系数 (NF) 测量：

1. 如图 3-3 所示，可以使用噪声二极管和频谱分析仪（或噪声系数分析仪），利用传统 Y 系数法进行 NF 测量。
2. 在进行测量时，请考虑到 EVM 板的任何射频电缆损耗。为了匹配而添加的任何外部输入衰减器会导致 NF 按比例下降，必须在测量中进行校准。
3. 此外，NF 测量中必须包含器件输入引脚处输入布线的板载损耗。
4. 如果器件输出端之后的损耗比较显著，则必须将输出损耗包含到 NF 测量中。使用 Friis 公式，通过测量的总 NF 计算器件的噪声系数。

3.3 双音 OIP3 测试设置

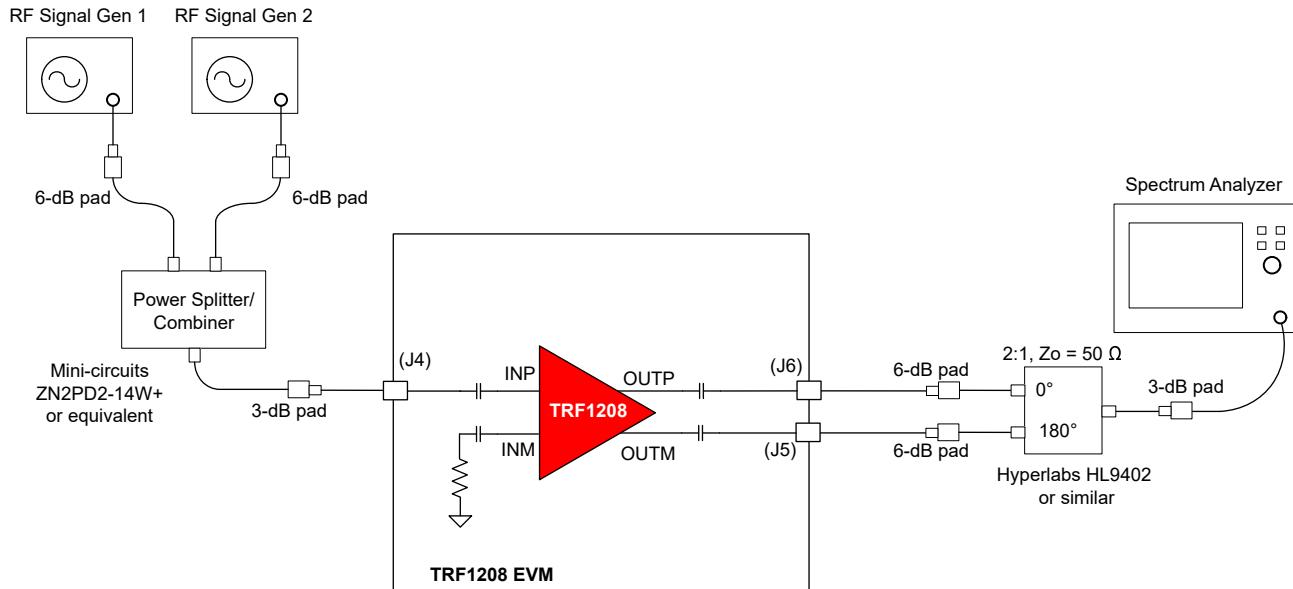


图 3-4. OIP3 测试设置

请按照以下指南进行双音 OIP3 测量：

1. 如图 3-4 所示，使用同相功率分离器和组合器合并两个信号发生器输出。建议对信号发生器输出使用 6dB 衰减器，以防发生器相互通信，并导致信号发生器 IMD3 杂散。
2. 将两个信号发生器输出设置为适当的功率级别和频率间隔，以便信号发生器在器件上产生所需的输出功率 (P_{OUT})。

测试设置图

3. TI 建议输出功率级别处于 TRF1208 器件的线性工作范围内。例如，如果在器件上所需的总输出功率为 8dBm，则相应地设置信号发生器，使每个基波输出功率的结果是 2dBm/子载波。一般情况下，TI 建议将总输出功率级别保持在比 1dB 压缩点低约 6dB 至 8dB。有关此器件支持的输出功率级别，请参阅器件数据表。
4. 对于 OIP3 测试，两个音调可以间隔指定的频率。
5. 相应地设定频谱分析仪衰减设置，使频谱分析仪非线性度不影响测量。
6. 使频谱分析仪 RBW 和 VBW 设置对主音和 IM3 产物保持相同。
7. 对于输出 IP3 计算，请考虑到 TRF1208 器件输出与频谱分析仪输入之间所需频带下的合并损耗。合并功率损耗是由于 PCB 输出布线、射频同轴电缆、O/180°无源平衡-非平衡变压器以及出于外部匹配目的而使用的任何衰减器垫导致的。[方程式](#) 给出了计算的 OIP3。

$$\text{输出 IP3} = (\text{P}_{\text{IN_SA}} - \text{IMD3}) / 2 + \text{P}_{\text{IN_SA}} + \text{P}_{\text{LOSS}}$$

其中，

- $\text{P}_{\text{IN_SA}}$ = 频谱分析仪的子载波输入功率
 - P_{LOSS} = 器件输出至频谱分析仪输入之间的功率损耗
 - IMD3 = 在 $2f_1 - f_2$ 或 $2f_2 - f_1$ 处记录的两个互调失真产物的较高功率
8. 在[方程式](#) 中， $\text{P}_{\text{IN_SA}} + \text{P}_{\text{LOSS}} = \text{P}_{\text{OUT}}$ 是放大器子载波输出功率。

4 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 德州仪器 (TI) , [TRF1208 单通道 10MHz 至 8GHz 1dB 带宽单端至差分放大器数据表](#)

5 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| Changes from Revision A (September 2021) to Revision B (August 2023) | Page |
|---|-------------|
| • 向说明部分添加了 TRF1208B..... | 2 |

| Changes from Revision * (September 2021) to Revision A (May 2022) | Page |
|--|-------------|
| • 更新了 增益和输出 P1dB 的单音设置图..... | 2 |
| • 更新了 TRF1208EVM 原理图插图..... | 4 |
| • 更新了 顶层图..... | 5 |
| • 更改了 S 参数测试设置图..... | 8 |
| • 更新了 噪声系数测试设置图..... | 9 |
| • 更改了 OIP3 测试设置图..... | 9 |

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023, 德州仪器 (TI) 公司